



中华人民共和国国家标准

GB 11094—89

水平法砷化镓单晶及切割片

Boat-grown gallium arsenide single
crystals and As-cut slices

1989-03-31 发布

1990-03-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

水平法砷化镓单晶及切割片

GB 11094—89

Boat-grown gallium arsenide single
crystals and As-cut slices

1 主题内容与适用范围

本标准规定了水平法砷化镓单晶及切割片的产品分类、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于水平法制备的砷化镓单晶及其切割片。产品供制作光电器件、微波器件和传感元件等元器件用。

2 引用标准

GB 4326 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

GB 8759 化合物半导体单晶晶向 X 射线衍射测量方法

GB 8760 砷化镓单晶位错密度测量方法

3 产品分类

3.1 导电类型

产品按导电类型分为 N 型和 P 型,按电阻率分为低阻导电型和高阻半绝缘型。以掺杂剂、载流子浓度和迁移率分类,按位错密度分级。

3.2 牌号

单晶及切割片的牌号分别表示为:

HBMGaAs - □ - □

